NUF8410MN

ESD保護機能内蔵 8チャネル**EMI**フィルタ

NUF8410MNは、ESD保護を内蔵した8チャネル(C-R-C)Piス タイルEMIフィルタ・アレイです。標準R = 100 Ωおよび C = 8.5 pFのコンポーネントで、250 MHzのカットオフ周波数 、および800 MHz~3.0 GHzの範囲にわたって-20 dBを超える ストップ・バンド減衰を提供します。

このような性能のため、NUF8410MNは、無線干渉を抑える 必要があるアプリケーションにおいて最大データ転送速度 167 Mbpsのパラレル・インタフェース用に最適です。規定さ れた減衰範囲は、2G/3G、GPS、Bluetooth®、およびWLAN信 号からの干渉を抑えるのに非常に有効です。

NUF8410MNは、ロープロファイル16リード1.6 mm x 4.0 mm のDFN16表面実装パッケージで提供されます。

特徴と利点

- 各チャネルで±8.0 kVのESD保護(IEC61000-4-2レベル4、接触 放電)
- 100 Ωと8.5 pFのR/C値で、250 MHz f_{3dB}の優れたS21性能特性、および800 MHz~3.0 GHzでの-20 dBのストップ・バンド減衰を提供
- EMI/ESDシステム・ソリューションをDFNパッケージに搭載 することで、低コスト、高いシステム信頼性、省スペースを 実現
- 鉛フリー・デバイス

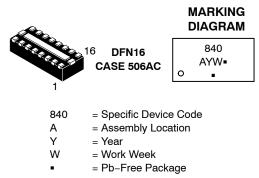
アプリケーション

- LCDおよびカメラ・データ・ライン用EMIフィルタ
- I/Oポートおよびキーパッド用EMIフィルタおよびEMI保護



ON Semiconductor®

http://onsemi.com



(*Note: Microdot may be in either location)

*Date Code orientation and/or position may vary depending upon manufacturing location.

ORDERING INFORMATION

	Device	Package	Shipping [†]
NUF	8410MNT4G	DFN16 (Pb-Free)	4000 / Tape & Reel

+For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

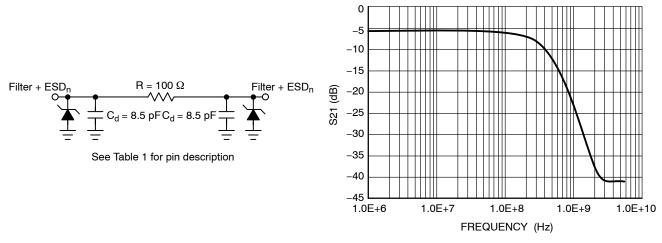


Figure 1. Electrical Schematic

Figure 2. Insertion Loss Characteristic

NUF8410MN

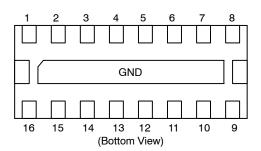


Figure 3. Pin Diagram

Table 1. FUNCTIONAL PIN DESCRIPTION

Filter	Device Pins	Description
Filter 1	1 & 16	Filter + ESD Channel 1
Filter 2	2 & 15	Filter + ESD Channel 2
Filter 3	3 & 14	Filter + ESD Channel 3
Filter 4	4 & 13	Filter + ESD Channel 4
Filter 5	5 & 12	Filter + ESD Channel 5
Filter 6	6 & 11	Filter + ESD Channel 6
Filter 7	7 & 10	Filter + ESD Channel 7
Filter 8	8 & 9	Filter + ESD Channel 8
Ground Pad	GND	Ground

MAXIMUM RATINGS

Parameter	Symbol	Value	Unit
ESD Discharge IEC61000-4-2 Contact Discharge	V _{PP}	8.0	kV
Operating Temperature Range	T _{OP}	-40 to 85	°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	–55 to 150	°C
Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes (1.8 in from case for 10 seconds)	ΤL	260	°C

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_J = $25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Тур	Max	Unit
Maximum Reverse Working Voltage	V _{RWM}				5.0	V
Breakdown Voltage	V _{BR}	I _R = 1.0 mA	6.0	7.0	8.0	V
Leakage Current	Ι _R	V _{RWM} = 3.3 V			100	nA
Resistance	R _A	I _R = 20 mA	85	100	115	Ω
Diode Capacitance	Cd	V _R = 2.5 V, f = 1.0 MHz		8.5	11	pF
Line Capacitance	CL	V _R = 2.5 V, f = 1.0 MHz		17	22	pF
3 dB Cut–Off Frequency (Note 1)	f _{3dB}	Above this frequency, appreciable attenuation occurs		250		MHz
6 dB Cut-Off Frequency	f _{6dB}	Above this frequency, appreciable attenuation occurs		395		MHz

1. 50 Ω source and 50 Ω load termination.

NUF8410MN

TYPICAL PERFORMANCE CURVES (T_A= 25°C unless otherwise specified)

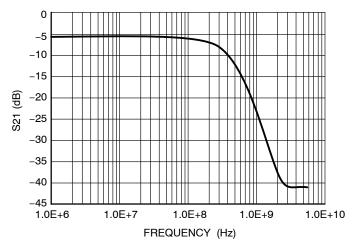
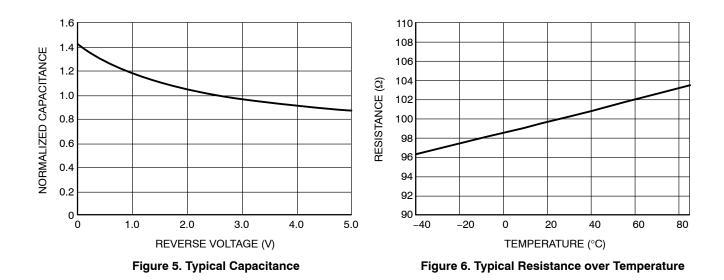


Figure 4. Insertion Loss Characteristic



動作理論

NUF8410MNは、ESD保護とEMIフィルタを一体化 し、サイズが制約された今日のアプリケーション向 けに小型パッケージに収納されています。標準的な 保護ダイオードに本質的に備わっている容量を利用 し、フィルタ内の直列抵抗に基づいて目的の周波数 応答を生成するのに必要な容量を提供します。この 機能を1個のデバイスに搭載することにより、多数 の個別部品が1個の小型パッケージに集積され、貴 重なボード・スペースの節約、アプリケーションの BOM数とコストの削減を実現します。

アプリケーション例

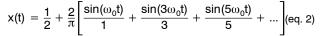
フィルタの帯域幅を指定する実際の方法は、3dB のカットオフ周波数を使用することです。6dBや 9dBなどのポイントをカットオフ周波数として使用 すると、アプリケーションで信号が劣化します。こ れはアプリケーション例を用いて説明できます。標 準的なアプリケーションには、たいていカメラや表 示インタフェースのデータ・ラインのEMIフィルタ が含まれます。そのような例では、最初に信号とス ペクトル成分を理解することが重要です。これらを 理解することによって、目的のアプリケーションに とって適切なフィルタを選択できます。通常のデー タ信号は、方形波に近い形でライン上を伝達される 1と0のパターンです。そのような信号の最大周波数 は、1-0-1-0のパターンになります。例えば、データ 転送速度が100 Mbpsの信号の場合、最大周波数成分 は50 MHzになります。次に考慮すべき点は信号のス ペクトル成分であり、これは方形波のフーリエ級数 近似によって理解できます。これを次のフーリエ級 数近似の式1と2で示します。

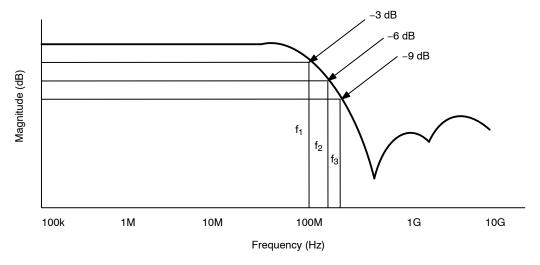
これらの式より、方形波が奇数次の高調波から成 り、完全な方形波を構成するにはnを無限大にする 必要があることが分かります。しかし、波形の許容 部分で保持するには、通常は最初の2つの項だけで 十分です。これらの2つの項には、信号振幅の約85% が含まれており、妥当な方形波を再構築できます。 したがって、周波数xの方形波を妥当な範囲で通過さ せるのに必要な最小フィルタ帯域幅は、3xになりま す。オン・セミコンダクターのすべてのEMIフィル タは、この原理に従って定格が定められています。 この原理に違反すると、波形に大きな丸みが生じ、 正しいデータ送信で問題が発生します。例として、 Figure 7に示すような応答特性を持つフィルタを取り 上げ、3種類のデータ波形を適用します。これらの3 種類の周波数を計算するために、3 dB、6d B、9 dB の帯域幅を使用します。

式1:

$$x(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{a} \left[\frac{1}{2n-1} sin((2n-1)\omega_0 t) \right] \quad (eq. 1)$$

式2(式1の簡略形式)







上述したように、フィルタを通過可能な波形の最 大サポート周波数は、帯域幅を3で割って求めること ができます(対応するデータ転送速度を求めるには、 この結果に2を掛ける)。

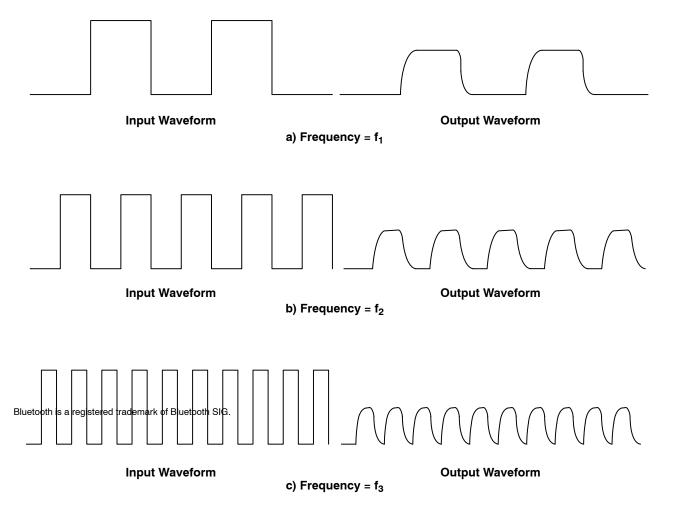
以下の表に、帯域幅の値、帯域幅に対応する最大サ ポート周波数、および第3高調波周波数を示します。

Bandwidth	Maximum Supported Frequency	Third Harmonic Frequency
3 dB – 100 MHz	33.33 MHz (f ₁)	100 MHz
6 dB – 200 MHz	66.67 MHz (f ₂)	200 MHz
9 dB – 300 MHz	100 MHz (f ₃)	300 MHz

Table 2. Frequency Chart

方形波の振幅の85%がフーリエ級数近似の最初の2 つの項に含まれることから、信号成分の大部分は基 本(最大サポート)周波数と第3高調波周波数にあると 考えられます。周波数33.33 MHzの信号をこのフィル タに入力した場合、最初の2項の成分は十分に通過し 、信号はFigure 8aに示すように軽く変形するだけで す。66.67 MHzの周波数の信号を同じフィルタに入力

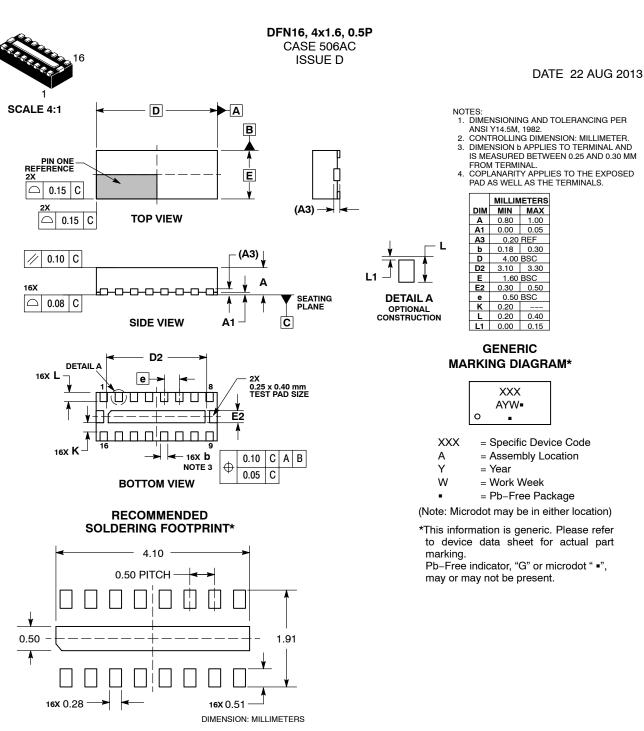
すると、第3高調波項の成分が大きく減衰します。こ れによって信号エッジに丸みが生じ、Figure 8bに示 すように波形が変形します。100 MHzの信号をこの フィルタに入力した場合、第3高調波項の成分がさら に減衰し、Figure 8cに示すように信号エッジにはさ らに大きな丸みが生じます。この結果、送信データ は劣化し、デジタル・データ(1と0から成る)はより判 別が困難になります。これには、シグナル・インテ グリティをさらに低下させる可能性がある相互接続 や他の経路損失など、その他の要因の影響は含まれ ていません。フィルタ製品によっては、6dBまたは 9dBの帯域幅を指定する場合がありますが、実際にそ れらの値を使用してサポート周波数(および対応する データ転送速度)を計算すると、大きな信号劣化が生 じます。最良のシグナル・インテグリティを得るに は、3 dBの帯域幅を使用して達成可能なデータ転送 速度を計算するのが最善の方法です。





Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG.





*For additional information on our Pb–Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

DOCUMENT NUMBER:	98AON19168D	Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository. Printed versions are uncontrolled except when stamped "CONTROLLED COPY" in red.			
DESCRIPTION: DFN16, 4.0X1.6 MM, 0.5 LEAD PITCH PAGE 1 C					
ON Semiconductor and unarrow are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba ON Semiconductor or its subsidiaries in the United States and/or other countries. ON Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products herein. ON Semiconductor makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does ON Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. ON Semiconductor does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.					

onsemi, ONSEMI, and other names, marks, and brands are registered and/or common law trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba "onsemi" or its affiliates and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. onsemi owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of onsemi's product/patent coverage may be accessed at <u>www.onsemi.com/site/pdf/Patent_Marking.pdf</u>. onsemi reserves the right to make changes at any time to any products or information herein, without notice. The information herein is provided "as-is" and onsemi makes no warranty, representation or guarantee regarding the accuracy of the information, product features, availability, functionality, or suitability of its products for any particular purpose, nor does onsemi assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or indental damages. Buyer is responsible for its products and applications using onsemi products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information provided by onsemi. "Typical" parameters which may be provided in onsemi data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. onsemi does not convey any license under any of its intellectual property rights nor the rights of others. onsemi products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification. Buyer shall indemnify and hold onsemi and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs,

ADDITIONAL INFORMATION

TECHNICAL PUBLICATIONS:

Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical-documentation onsemi Website: www.onsemi.com

ONLINE SUPPORT: <u>www.onsemi.com/support</u> For additional information, please contact your local Sales Representative at <u>www.onsemi.com/support/sales</u>